(19) Weltorganisation für geistiges Eigentum Internationales Büro



(43) Internationales Veröffentlichungsdatum 15. September 2005 (15.09.2005)

PCT

(10) Internationale Veröffentlichungsnummer WO 2005/085829 A1

- (51) Internationale Patentklassifikation⁷: G01N 27/414, 33/487
- (21) Internationales Aktenzeichen: PCT/EP2005/002128
- (22) Internationales Anmeldedatum:

1. März 2005 (01.03.2005)

(25) Einreichungssprache:

Deutsch

(26) Veröffentlichungssprache:

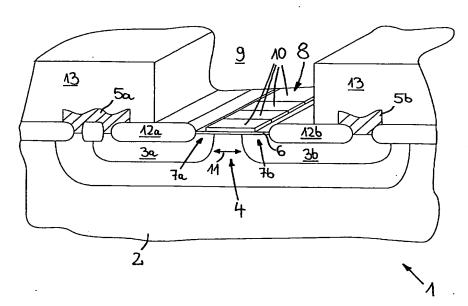
Deutsch

- (30) Angaben zur Priorität: 10 2004 010 635.5 2. März 2004 (02.03.2004) DE
- (71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme von US): MICRONAS GMBH [DE/DE]; Hans-Bunte-Strasse 19, 79108 Freiburg i.Br. (DE).

- (72) Erfinder; und
- (75) Erfinder/Anmelder (nur für US): BAUMANN, Werner [DE/DE]; Riedmattenstrasse 18, 77815 Bühl (DE). LEHMANN, Mirko [DE/DE]; Sudetenstrasse 4, 79117 Freiburg (DE). FREUND, Ingo [DE/DE]; Eichrodtstrasse 1, 79117 Freiburg (DE). GAHLE, Hans-Jürgen [DE/DE]; Panoramastrasse 13, 79312 Emmendingen (DE).
- (74) Anwalt: HUWER, Andreas; Grünwälderstrasse 10-14, Postfach 1305, 79013 Freiburg i.Br. (DE).
- (81) Bestimmungsstaaten (soweit nicht anders angegeben, für jede verfügbare nationale Schutzrechtsart): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, SY, TJ,

[Fortsetzung auf der nächsten Seite]

- (54) Title: FIELD EFFECT TRANSISTOR FOR MEASURING BIOCOMPONENTS
- (54) Bezeichnung: FELDEFFEKTTRANSISTOR FÜR MESSUNGEN AN BIOKOMPONENTEN



(57) Abstract: The invention relates to a device for measuring living cells or similar biocomponents comprising a field effect transistor (1) which is provided with a source, a drain and a channel area (4) placed on a substrate. Said channel area (4) connects said source and drain and is provided with a gate-electrode (8) mounted thereon. The gate electrode (8) has at least two laterally disposed parallel electrode areas (10) which are perpendicular to a direction in which the channel area (4) connects the source (3a) to the drain (3b) in such a way that they are distant and electrically insulated from each other.

- TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.
- (84) Bestimmungsstaaten (soweit nicht anders angegeben, für jede verfügbare regionale Schutzrechtsart): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), eurasisches (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), europäisches (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

Erklärung gemäß Regel 4.17:

— Erfindererklärung (Regel 4.17 Ziffer iv) nur für US

Veröffentlicht:

- mit internationalem Recherchenbericht
- vor Ablauf der f\(\tilde{u}\)r \(\tilde{A}\)nderungen der Anspr\(\tilde{u}\)che geltenden
 Frist; Ver\(\tilde{o}\)flentlichung wird wiederholt, falls \(\tilde{A}\)nderungen
 eintreffen

Zur Erklärung der Zweibuchstaben-Codes und der anderen Abkürzungen wird auf die Erklärungen ("Guidance Notes on Codes and Abbreviations") am Anfang jeder regulären Ausgabe der PCT-Gazette verwiesen.